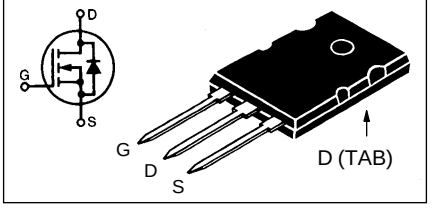
Preliminary Data

	V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$	t_{rr}
IXFK/FN 36N60	600V	36A	0.18Ω	250ns
IXFK/FN 32N60	600V	32A	0.25Ω	250ns

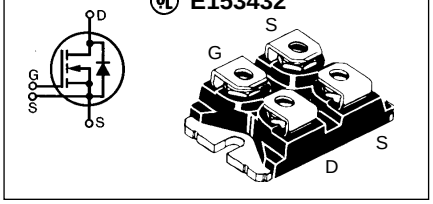
HiPerFET™ Power MOSFET

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dv/dt, Low t_{rr}

TO-264 AA (IXFK)



miniBLOC, SOT-227 B (IXFN)
UL E153432



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain
Either Source terminal at miniBLOC can be used as Main or Kelvin Source

Symbol	Test Conditions		Maximum Ratings IXFK	IXFN	
V_{DSS}	T_J = 25°C to 150°C		600	600	V
V_{DGR}	T_J = 25°C to 150°C; R_{GS} = 1 MΩ		600	600	V
V_{GS}	Continuous		±20	±20	V
V_{GSM}	Transient		±30	±30	V
I_{D25}	T_C = 25°C, Chip capability	32N60	32	32	A
		36N60	36	36	A
I_{DM}	T_C = 25°C, pulse width limited by T_{JM}	32N60	128	128	A
		36N60	144	144	A
I_{AR}	T_C = 25°C		20	20	A
E_{AR}	T_C = 25°C		30	30	mJ
dv/dt	$I_S \le I_{DM}$, di/dt ≤ 100 A/µs, $V_{DD} \le V_{DSS}$ $T_J \le 150°C$, R_G = 2 Ω		5	5	V/ns
P_D	T_C = 25°C		500	520	W
T_J			-55 ...	+150	°C
T_{JM}				150	°C
T_{stg}			-55 ...	+150	°C
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s		300	-	°C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMSt = 1 min		-	2500	V~
	$I_{ISOL} \le$ 1 mAt = 1 s		-	3000	V~
M_d	Mounting torque		0.9/6	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque		-	1.5/13	Nm/lb.in.
Weight			10	30	g

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified) Min.	Typ.	Max.	
V_{DSS}	V_{GS} = 0 V, I_D = 1 mA		600			V
$V_{GH(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, I_D = 8 mA		2		4.5	V
I_{GSS}	V_{GS} = ±20 V_{DC}, V_{DS} = 0				±200	nA
I_{DSS}	V_{DS} = 0.8 V_{DSS}	T_J = 25°C			400	µA
	V_{GS} = 0 V	T_J = 125°C			2	mA
$R_{DS(on)}$	V_{GS} = 10 V, I_D = 0.5 I_{D25}	36N60			0.18	Ω
	Pulse test, t ≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %	32N60			0.25	Ω

Features

- International standard packages
- JEDEC TO-264 AA, epoxy meet UL 94 V-0, flammability classification
- miniBLOC with Aluminium nitride isolation
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- Fast intrinsic Rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

IXYS Corporation
3540 Bassett Street, Santa Clara, CA 95054
Tel: 408-982-0700 Fax: 408-496-0670

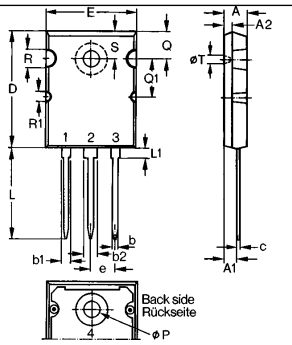
IXYS Semiconductor
Edisonstr. 15, D-68623 Lampertheim, Germany
Tel: +49-6206-5030 Fax: +49-6206-503629

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified) min.	typ.	max.	
g_{fs}	V_{DS} = 10 V; I_D = 0.5 I_{D25}, pulse test		36		S
C_{iss}	V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V, f = 1 MHz		9000		pF
C_{oss}			840		pF
C_{rss}			280		pF
$t_{d(on)}$	V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25} R_G = 1 Ω (External),		30		ns
t_r			45		ns
$t_{d(off)}$			100		ns
t_f			60		ns
$Q_{g(on)}$	V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}		325		nC
Q_{gs}			60		nC
Q_{gd}			120		nC
R_{thJC}	TO-264 AA			0.25	K/W
R_{thCK}	TO-264 AA		0.15		K/W
R_{thJC}	miniBLOC, SOT-227 B			0.24	K/W
R_{thCK}	miniBLOC, SOT-227 B		0.05		K/W

Source-Drain Diode

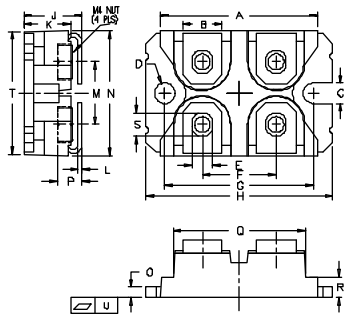
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified)	Min.	Typ.	Max.	
I_S	V_{GS} = 0	36N60			36	A
I_S	V_{GS} = 0	32N60			32	A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}	36N60			144	A
		32N60			128	A
V_{SD}	I_F = I_S A, V_{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 µs, duty cycle d ≤ 2 %				1.5	V
t_{rr}	I_F = I_S, -di/dt = 100 A/µs, V_R = 100 V				250	ns
I_{RM}				20		A

TO-264 AA Outline



Dim.	Millimeter Min.	Max.	Inches Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

miniBLOC, SOT-227 B



M4 screws (4x) supplied

Dim.	Millimeter Min.	Max.	Inches Min.	Max.
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	38.00	38.23	1.496	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.76	0.84	0.030	0.033
M	12.60	12.85	0.496	0.506
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.98	2.13	0.078	0.084
P	4.95	5.97	0.195	0.235
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.174
S	4.72	4.85	0.186	0.191
T	24.59	25.07	0.968	0.987
U	-0.05	0.1	-0.002	0.004

Fig.1. Output Characteristics

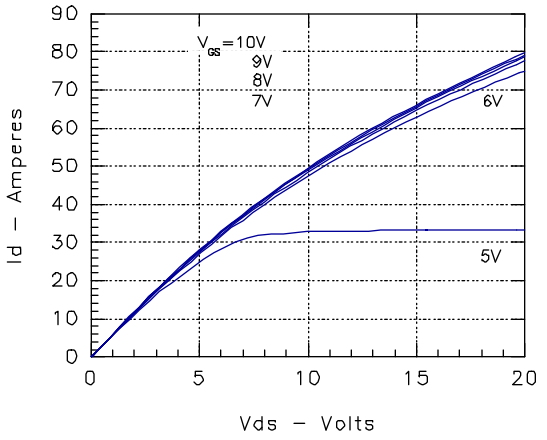


Fig. 2. Input Admittance

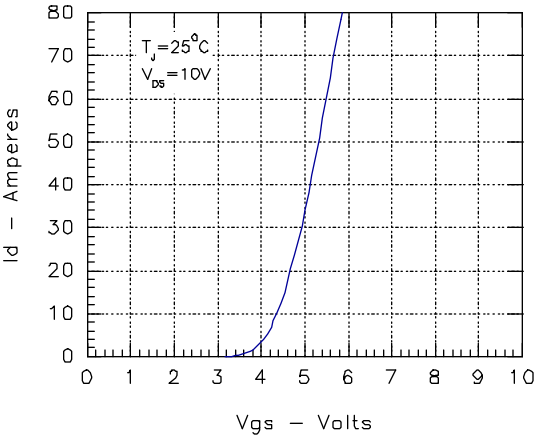


Fig. 3. Rds(on) vs. Drain Currente

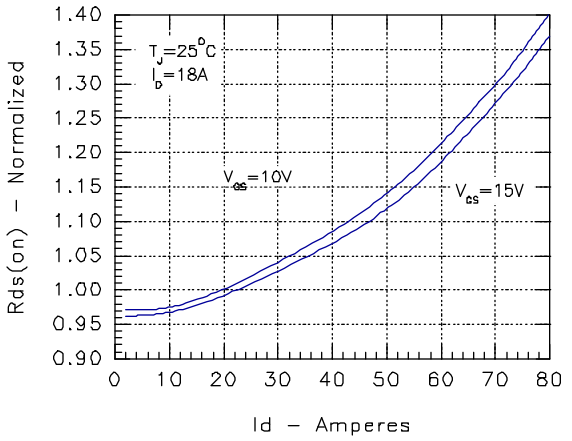


Fig. 4. Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

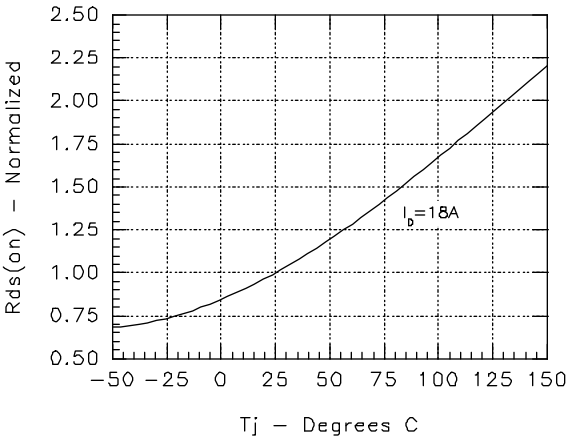


Fig. 5. Drain Current vs. Case Temperature

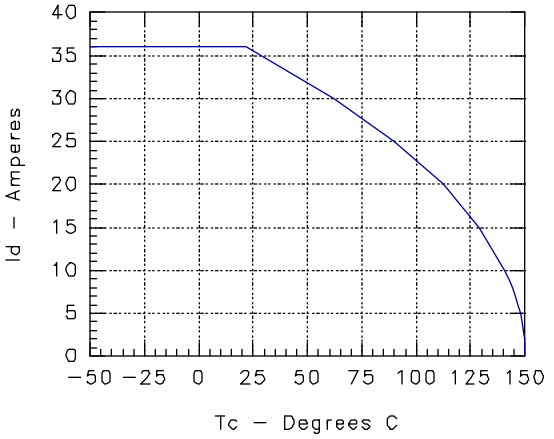
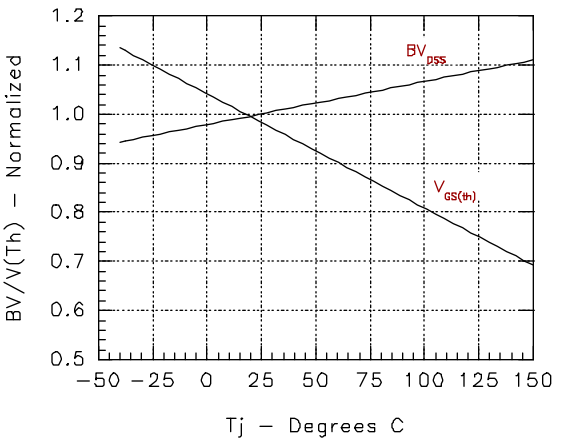


Fig. 6. Temperature Dependence of Breakdown Voltage and Threshold Voltage



IXYS Corporation
3540 Bassett Street, Santa Clara,CA 95054
Tel: 408-982-0700 Fax: 408-496-0670

IXYS Semiconductor
Edisonstr. 15, D-68623 Lampertheim, Germany
Tel: +49-6206-5030 Fax: +49-6206-503629

Fig. 7. Gate Charge

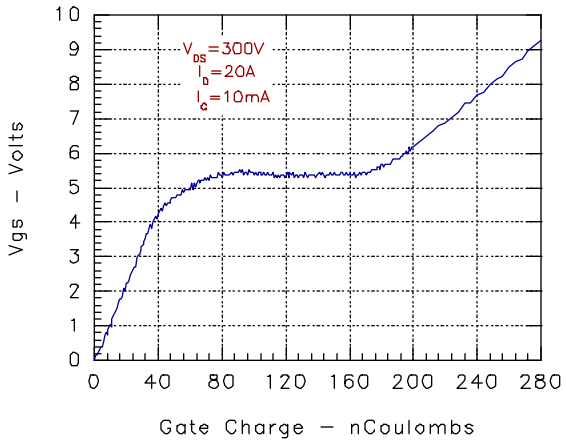


Fig. 8. Capacitance Curves

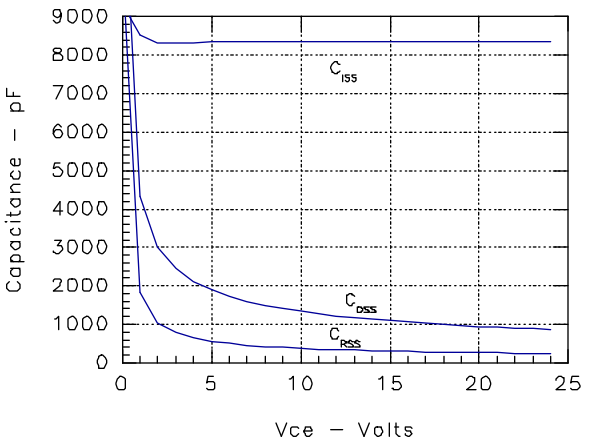


Fig. 9. Source Current vs. Source to Drain Voltage

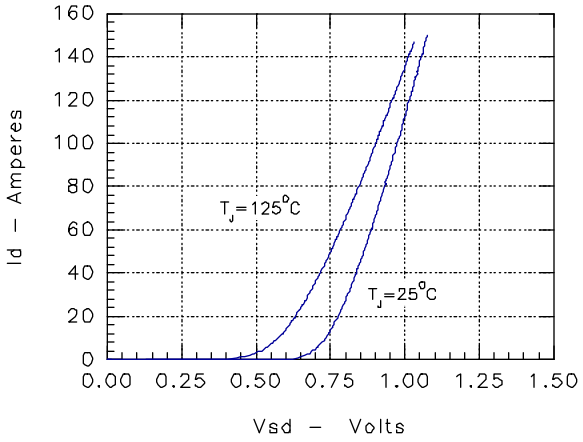
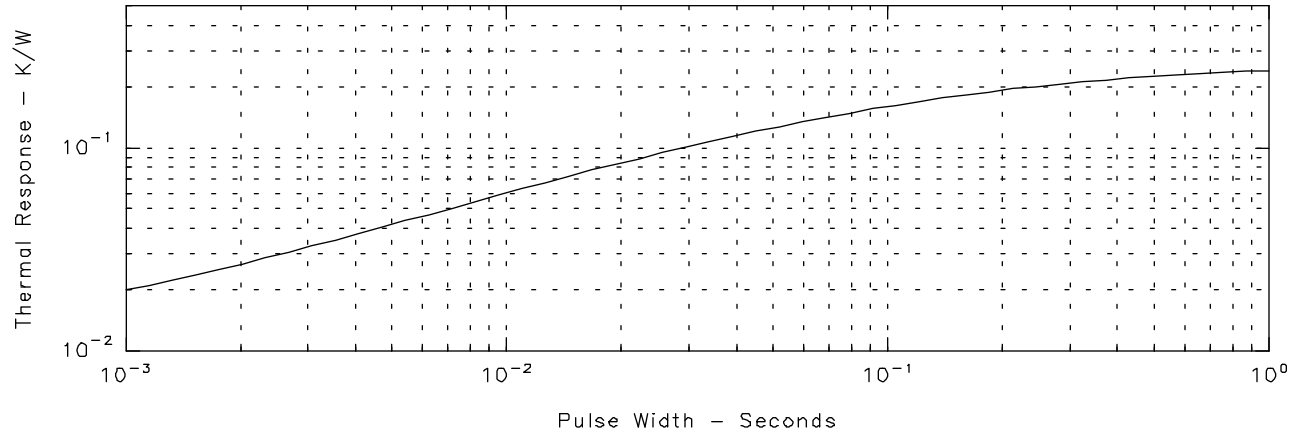


Fig. 10. Transient Thermal Impedance



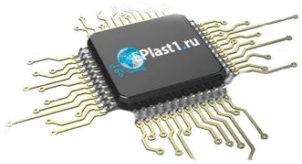
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.